

Чертежи прилагаются к ТУ.

Металлизация лицевой стороны транзистора – алюминий, обратной стороны – серебро.

В.4 Масса транзисторов приведена в таблице В.2.

Таблица В.2

Условное обозначение транзисторов	Масса, г, не более
2П707Б-5	0,037
2П707В-5	0,037
2П767В-5	0,0287
2П767Ж-5	0,0287
2П768К2-5	0,037
2П768П-5	0,037
2П770К-5	0,042
2П770К2-5	0,037
2П770П-5	0,037
2П782Ж-5	0,037
2П782Ж2-5	0,037
2П793Б-5	0,0432
2П794А-5	0,0625
2П794А1-5	0,071
2П794В-5	0,071
2П794Б-5	0,0625
2П795А-5	0,073
2П795А4-5	0,071
2П795Б-5	0,0625

В.5 Описание образцов внешнего вида транзисторов КФДЛ.430204.007Д прилагается к ТУ.

В.6 Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке соответствуют нормам, приведенным в таблице В.3.

Таблица В.3

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Бук- венное обозна- чение	Норма		Темпе- ратура среды, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Начальный ток стока, мкА ($U_{СИ} = 600 \text{ В}$, $U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П707Б-5;	$I_{С.нач}$	—	25	25 ± 10

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					184
21307-9				21307-8					
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подпись и дата	

Продолжение таблицы В.3

1	2	3	4	5
$U_{СИ} = 800 \text{ В}, U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П707В-5; $U_{СИ} = 200 \text{ В}, U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П793Б-5; $U_{СИ} = 400 \text{ В}, U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5; $U_{СИ} = 500 \text{ В}, U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П770К-5, 2П770К2-5, 2П770П-5; 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5; $U_{СИ} = 60 \text{ В}, U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5)		—	25	
		—	25	
		—	25	
		—	25	
		—	25	
Ток утечки затвора, нА $(U_{ЗИ} = 20 \text{ В}, U_{СИ} = 0 \text{ В};$ $U_{ЗИ} = -20 \text{ В}, U_{СИ} = 0 \text{ В})$	$I_{з,ут}$	—	500	25 ± 10
		—	$ -500 $	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом $(U_{ЗИ} = 10 \text{ В}, I_C = 1 \text{ А}, \tau_{и} = 1000 \text{ мкс}$ 2П707Б-5; 2П707В-5; 2П767В-5; 2П767Ж-5, 2П793Б-5; 2П768К2-5, 2П770П-5; 2П768П-5; 2П770К-5, 2П770К2-5; 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5; 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5; 2П794В-5; 2П795А-5, 2П795А4-5; 2П795Б-5)	$R_{СИ.отк}$	—	2	25 ± 10
		—	3	
		—	0,18	
		—	0,12	
		—	0,55	
		—	0,42	
		—	0,85	
		—	0,028	
		—	0,3	
		—	0,2	
		—	0,4	
		—	0,6	
Пороговое напряжение, В $(U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 10 \text{ мА}$ 2П707Б-5; $U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 250 \text{ мкА}$ 2П707В-5, 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П770К-5, 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5, 2П793Б-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5, 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5)	$U_{ЗИ.пор}$	2,0	5,0	25 ± 10
		1,5	6,0	

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					185
21307-9				21307-8					
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подпись и дата	

Окончание таблицы В.3

1	2	3	4	5
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_{\text{и}} = 1 \text{ А}$, $U_{\text{зи}} = 0 \text{ В}$, $\tau_{\text{и}} = 1000 \text{ мкс}$)	$U_{\text{ис}}$	—	1,0	25 ± 10
Пробивное напряжение диода, В ($U_{\text{зи}} = 0 \text{ В}$, $I_{\text{с}} = 10 \text{ мА}$, $\tau_{\text{и}} \leq 500 \text{ мкс}$ 2П707Б-5; 2П707В-5; 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П794А1-5, 2П794В-5; 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П795А4-5; 2П782Ж2-5)	$U_{\text{си}}$	600	—	25 ± 10
		800	—	
		400	—	
		500	—	
		60	—	

В.7 Измерение пробивного напряжения диода $U_{\text{си}}$ проводят согласно ГОСТ 18986.24 в режимах и условиях, указанных в таблице В.3.

Погрешность измерения параметра $U_{\text{си}} - \pm 2 \%$.

В.8 Технологический процесс разделения транзисторов у потребителя в случае поставки на общей пластине должен быть согласован с предприятием-изготовителем транзисторов.

В.9 Упаковка транзисторов на общей пластине производится в потребительскую групповую тару КФДЛ.321312.018 или И94.180.131 и транспортную тару И94.171.008.

Упаковка транзисторов в кристаллах производится в потребительскую групповую тару КФДЛ.735233.001 или КФДЛ.321312.023 и транспортную тару И94.171.008.

В.10 При монтаже транзисторов в гибридные интегральные микросхемы необходимо выполнять следующие условия:

а) монтаж транзисторов в гибридные интегральные микросхемы необходимо выполнять с помощью пайки в инертной среде. Температура пайки $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$;

б) присоединение выводов к контактным площадкам должно производиться ультразвуковой сваркой. В качестве вывода истока должна применяться проволока марки АОЦПоМ – 250 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П707Б-5, 2П770К-5; проволока марки АОЦПоМ – 400 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П707В-5, 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П793Б-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5, 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5; две проволоки марки АОЦПоМ – 400 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5; в качестве

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ			Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				186
21307-9				21307-8				
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№		Инв.№ дубл.		Подпись и дата

вывода затвора проволока марки АК 0,9 ПМ – 100 (ТУ 6365-051-46594157-2004);

в) выводы после ультразвуковой сварки не должны касаться структуры и боковых ребер транзистора;

г) во избежание разрушения транзистора во время приварки выводов необходимо следить, чтобы рабочий инструмент и сварные точки находились внутри контактной площадки;

д) не допускается сильное натяжение и провисание выводов;

е) не допускается разрыв (пережатие) вывода в месте сварки;

ж) при пайке транзистора не допускается затекание припоя на структуру транзистора;

и) после извлечения транзисторов из упаковки изготовителя до присоединения выводов к контактным площадкам транзисторы должны находиться в специальной камере с инертной средой не более 10 суток.

В.11 Предприятие-изготовитель транзисторов в бескорпусном исполнении гарантирует соответствие изделия требованиям АЕЯР.432140.273ТУ в течение гарантийного срока и гарантийный наработки, указанных в ТУ, при соблюдении предприятием-изготовителем изделия аналога режимов сборки, условий межоперационного хранения, проведения отбраковочных испытаний, а предприятием-потребителем правил транспортирования и хранения, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных РД 11 0723 и АЕЯР.432140.273ТУ.

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			187
21307-9				21307			
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	